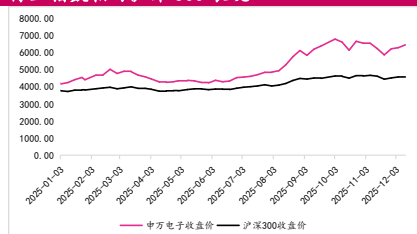


电子行业

2025 年 12 月 14 日

涨幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
富信科技	59.00	45.57	52.06
东田微	185.88	35.90	148.70
赛微电子	62.33	29.37	456.39
鸿日达	70.41	27.93	145.52
立昂微	37.29	26.84	250.36
跌幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
惠伦晶体	8.44	-18.53	23.70
华映科技	5.02	-16.61	138.85
*ST 宇顺	29.78	-15.06	83.46
睿能科技	25.53	-13.78	52.99
泓禧科技	28.97	-12.40	21.44

行业指数相对沪深 300 表现



相关报告

【金元电子】周报 20251109 寒武纪优化基础软件平台，或加速国产算力落地

【金元电子】周报 20251117 中芯国际三季度产品结构、产能利用率改善，毛利率超预期

【金元电子】周报 20251123 谷歌推出 Gemini 3 Pro，推理、多模态、长上下文能力提升

【金元电子】周报 20251130 太空数据中心建设，开启“天地协同新方案”

【金元电子】周报 20251207 DeepSeek V3.2 提升推理及 Agent 潜在能力

分析师：唐仁杰

执业证书编号：S0370524080002

电话：0755-83025184

邮箱：tangrj@jyzq.cn

行业周度点评报告

—3D NAND 或成为存储新增长曲线

评级：增持（维持）

- **全行业：**本周上证指数下跌0.34%，深证成指上涨0.84%，沪深300指数下跌0.08%，申万电子版块上涨2.63%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为3/31。板块个股涨幅前五名分别为：富信科技、东田微、赛微电子、鸿日达、立昂微；跌幅前五名分别为：惠伦晶体、华映科技、*ST宇顺、睿能科技、泓禧科技。
- **电子行业：**电子行业呈现涨跌分化格局，从申万二级行业数据看，子板块涨跌互现，部分板块内部结构差异显著。电子化学品板块本周上涨6.99%，为本周表现最强的方向；其下申万三级行业电子化学品III同幅上涨6.99%，走势完全一致。元件板块上涨6.08%，表现同样亮眼；其下申万三级行业印制电路板上涨7.03%、被动元件上涨1.52%，细分领域涨幅分化。其他电子板块上涨5.60%；其下申万三级行业其他电子III同幅上涨5.60%，走势同步。半导体板块本周上涨2.68%，内部结构差异较大；其下申万三级行业半导体材料上涨6.48%、半导体设备上涨4.60%、分立器件上涨4.17%，是板块核心拉动力量；数字芯片设计上涨1.42%、模拟芯片设计上涨1.28%、集成电路封测上涨0.96%，内部涨幅分化突出。消费电子板块整体上涨0.37%，延续温和态势；其下申万三级行业消费电子零部件及组装上涨0.44%，对板块形成支撑，品牌消费电子下跌0.41%。光学光电子板块本周下跌0.22%，表现相对弱势；其下申万三级行业光学元件上涨5.60%，而面板下跌3.02%、LED下跌0.48%，细分领域涨跌分化明显。总体来看，本周电子行业子板块涨跌分化显著，电子化学品、元件等领涨，半导体板块内部分化突出，光学光电子表现偏弱，行业呈现局部活跃但整体涨跌不一的态势。
- **行业要闻**
 - ◆ SK海力士正与英伟达合作加快下一代Nand开发，目标到2027年实现存储性能的大幅提升。
 - ◆ 记忆体超级周期挡不住，华邦电11月营收创41个月最佳表现线
 - ◆ 台积电CoWoS先进封装全线满载，外包订单加速英伟达、苹果芯片交付
 - ◆ 高通宣布收购Ventana Micro Systems
 - ◆ 英伟达被曝开发“芯片定位”技术，H200芯片装上“安全枷锁”
- **公司动态：**
 - ◆ 经纬辉开：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
 - ◆ 科森科技：关于出售全资子公司股权的公告
 - ◆ 兴福电子：关于购买资产暨关联交易的公告
 - ◆ 冠捷科技：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
 - ◆ 新相微：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
- **投资建议：**我们认为，在易失性存储（如 DRAM）在 HBM、HMC 等领域突破后，随着 AI 推理及应用市场的持续扩张，尽管高带宽内存（HBM）解决了核心计算单元的数据吞吐问题，但在海量数据集的检索、向量数据库的索引遍历以及大模型的检查点恢复过程中，底层非易失性存储（NAND Flash）的读写性能，尤其是随机读取（IOPS）和能效比已成为制约系统整体效率的关键短板。下一步在非易失性存储（NAND、HDD）领域或将引起行业重视。从制造工艺上而言，3D 结构的 NAND 存储工艺难点在于高深宽比的刻蚀工艺、薄膜沉积及未来可能成为主流的混合键合工艺，如长江存储在 Xtacking 2.0 阶段采用键合工艺将层数由 64 层扩展至 128 层，也验证了键合工艺的重要性。对于半导体产业链而言，AI-NAND 的发展意味着低温刻蚀、混合键合、薄膜沉积、CMP 技术的设备商或将迎来 NAND 推动下的景气周期。由于工艺复杂度提升，设备在晶圆成本中的占比将持续上升。
- **相关公司：**1、设备商：中微公司（刻蚀）、拓荆科技（薄膜沉积+混合键合）、盛美上海（湿法刻蚀+清洗+电镀）、精智达（测试）等；2、材料：鼎龙股份、安集科技、华特气体、南大光电等
- **风险提示：**1、AI 推理不及预期：推理侧是 AI 应用及 AI 商业化的核心要素，也是存储周期的核心需求因素，若 AI 推理市场不及预期，或导致周期下行；2、生产端不及预期：国内设备及材料厂商仍处于追赶阶段，渗透率仍有待提升；3、工艺良率不及预期：3D NAND 及 HBM 封装技术仍不成熟，量产良率仍有待印证。

请务必仔细阅读本报告最后部分的免责声明

曙光在前金元在先

目录

一、核心观点3

二、行业跟踪9

三、行业新闻12

四、公司公告18

五、下周重要事件提示23

图表目录

图 1：针对 AI 推理阶段，对于存储的需求不同4

图 2：HBF 架构4

图 3：未来存储架构的变化5

图 4：3D NAND 技术发展路线5

图 5：3D NAND 面临的多层不均匀问题及刻蚀弯曲、底部未打通问题6

图 6：长江存储 3D NAND 层数领先7

图 7：本周各行业版块涨跌幅9

图 8：本周电子版块：子版块涨跌幅10

图 9：电子板块历史走势11

图 10：电子板块历史市盈率11

表 1：本周电子板块个股涨幅前五名9

表 2：本周电子版块个股跌幅前五名9

表 3：下周重要会议23

表 4：电子行业限售股解禁情况汇总（单位：万股）25

一、核心观点

根据 TrendForce 报道，SK 海力士正与英伟达合作加快下一代 Nand 开发，目标到 2027 年实现存储性能的大幅提升。

随着生成式人工智能从单纯的模型训练迈向大规模推理与应用部署阶段，计算系统的瓶颈正经历一场从算力（Compute-bound）向存储（Memory-bound）的剧烈转移。尽管高带宽内存（HBM）解决了核心计算单元的数据吞吐问题，但在海量数据集的检索、向量数据库的索引遍历以及大模型的检查点恢复过程中，底层非易失性存储（NAND Flash）的读写性能，尤其是随机读取（IOPS）和能效比已成为制约系统整体效率的关键短板。

在传统的数据中心架构中，存储系统的设计主要围绕着容量密度与成本（Cost per bit）展开。然而，大语言模型（LLM）与混合专家模型（MoE）的兴起根本性地改变了这一逻辑。AI 工作负载呈现出高度的双模态特征：

- 训练阶段（Training）：需要极高的顺序写入带宽以支持断点续训（Checkpointing）。随着模型参数量突破万亿级，单次 Checkpoints 的数据量可达数 TB，若存储写入速度不足，昂贵的 GPU 集群将被迫闲置等待数据落盘。
- 推理阶段（Inference）：尤其是结合了检索增强生成（RAG）技术的应用，对存储提出了近乎苛刻的随机读取要求。向量数据库（Vector Database）在进行语义搜索时，需要以极高的并发度读取数百万个微小的向量索引（通常为 512 字节或 4KB）。传统的企业级 SSD 控制器针对大块数据优化，在处理这种细粒度、高并发的随机读取时，效率极低，导致了严重的“数据饥渴”现象。

当前最先进的 PCIe Gen 5 企业级 SSD，其随机读取性能通常徘徊在 200 万至 300 万 IOPS 之间。面对 NVIDIA Blackwell 等新一代 GPU 高达数十 PFLOPS 的算力，存储 I/O 与计算吞吐之间存在着几个数量级的鸿沟。这种不匹配迫使 AI 系统设计者不得不堆叠过量的 HBM 或 DRAM 来缓存数据，极大地推高了总拥有成本（TCO）。

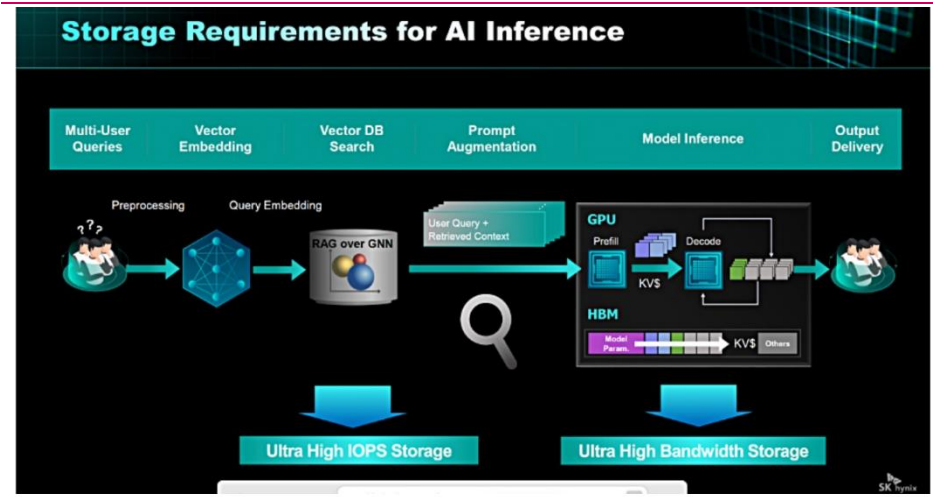
为了应对 AI 应用的多样化需求，SK 海力士推出了全新的“AIN”（AI-NAND）产品矩阵，包含三个针对不同维度的子系列，形成了完整的 AI 存储生态闭环。

AIN-P 是本次合作的旗舰产品，专为 AI 推理和向量搜索设计：

- 技术规格：目标是在 2026 年下半年推出首批样品，基于 PCIe Gen 6 接口实现 5000 万 IOPS；并在 2027 年量产版中，利用 PCIe Gen 6+ 或 Gen 7 接口，达成 1 亿 IOPS 的终极目标。
- 架构创新：传统 SSD 控制器无法承受 1 亿 IOPS 带来的指令处理压力。AIN-P 将采用重新设计的控制器架构，支持 512 字节的超细粒度访问。这意味着在同样的带宽下，系统可以完成更多次的有效数据存取，精准匹配向量数据库的索引查找模式。
- 接口挑战：研究显示，单条 PCIe 6.0 x4 通道的物理带宽上限约为 31GB/s，

而维持 1 亿次 512 字节的 IOPS，理论带宽需求接近 48GB/s。因此，实现这一目标不仅需要 NAND 颗粒的速度提升，更需要接口位宽的扩展（如 x8/x16）或采用新型互连协议（如 NVIDIA 私有的 NVLink 变体或光互连技术）

图 1：针对 AI 推理阶段，对于存储的需求不同



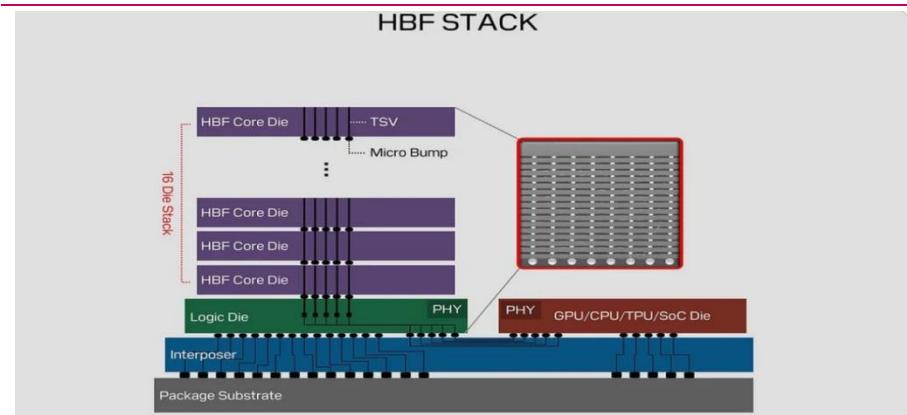
数据来源：SK 海力士，金元证券研究所整理

AIN-B (Bandwidth)：高带宽闪存（HBF）。 AIN-B，即 High Bandwidth Flash（HBF），是 SK 海力士与 SanDisk（西部数据）联合推动的行业标准，意在复制

HBM 在 DRAM 领域的成功路径：

- 设计理念：HBF 摒弃了传统 SSD 的封装形式，采用了类似 HBM 的垂直堆叠封装。通过硅通孔（TSV）技术将多个 NAND Die 堆叠，并直接键合到底部的逻辑控制芯粒（Base Die）上。
- 性能定位：HBF 旨在提供远超传统 SSD、接近低端 DRAM 的带宽，同时具备 NAND 的高密度特性。其容量可达 HBM 的 8 至 16 倍，主要用于存储大模型的 KV Cache（键值缓存）或作为“热”模型参数的驻留地，从而释放昂贵的 HBM 空间用于计算

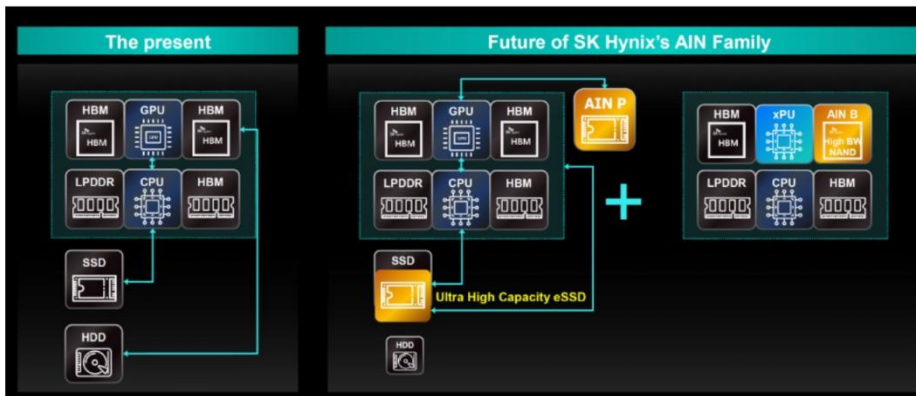
图 2：HBF 架构



数据来源：闪迪，金元证券研究所整理

AIN-D (Density): PB 级容量的基石。 AIN-D 系列则聚焦于超高密度，计划利用 3D QLC 乃至 PLC（五层单元）技术，将单一服务器机架的存储容量推向 PB（Petabyte）级别。这旨在彻底取代近线硬盘（Nearline HDD），为 AI 数据湖提供高吞吐、低延迟的底层存储底座

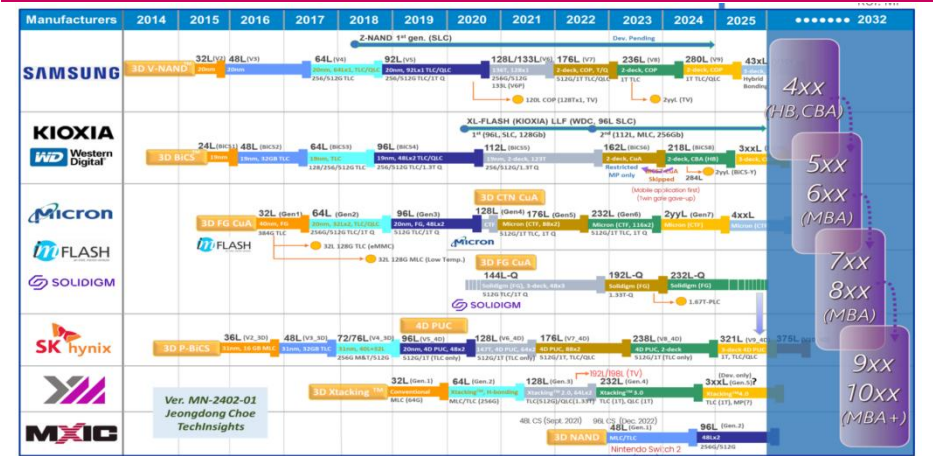
图 3：未来存储架构的变化



数据来源：SK 海力士，金元证券研究所整理

从 NAND 发展角度而言，NAND Flash 本身的物理结构必须经历深刻的变革。目前主流技术正从 200+层向 300+层过渡，而行业路线图已指向 1000 层堆叠。3D-NAND 架构或成为高端算力芯片的主流配置。SK 海力士已展示了 321 层样片，预计 2025 年投入量产。而 Samsung 的 V10 技术规划将突破 400 层，并引入混合键合技术。行业共识是，通过双栈（Double Stack）或三栈（Triple Stack）串联技术，并在 2030 年前后达成 1000 层堆叠的目标。

图 4：3D NAND 技术发展路线



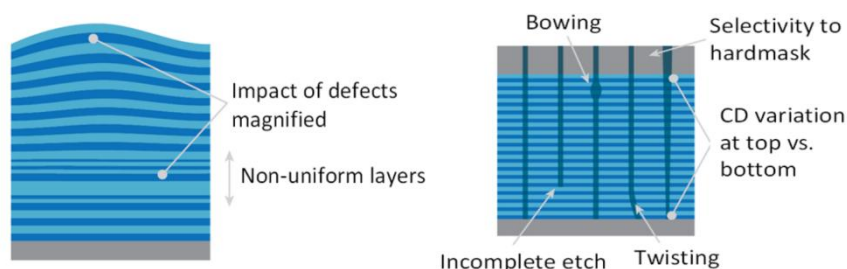
数据来源：Tech Insights，金元证券研究所整理

在 2D（平面）NAND 时代，制造商通过缩小存储单元的物理尺寸（光刻节点微缩）来增加密度，从 50nm 一路微缩至 15nm 级。然而，当制程逼近 10nm 时，相邻存储单元之间的电子干扰（Crosstalk）和电子泄漏变得无法控制，平面微缩撞上

了物理“墙”。为了突破这一瓶颈，行业转向了 3D NAND。其核心逻辑不再是缩小单元面积，而是将存储单元（Memory Cell）垂直堆叠。这种架构的本质，是在硅片上构建多层结构。因此，所有的 3D NAND 在物理形态上必然是“多层”的。这种垂直堆叠结构通过在交替的导电层和绝缘层（ONON Stack）中钻孔（Channel Hole），形成垂直的 NAND 串（String）。

在物理上，要一次性通过光刻和刻蚀工艺打通数百层材料，面临着极大的挑战。深宽比（Aspect Ratio，即孔深与孔径之比）过高会导致刻蚀孔发生扭曲、弯曲（Bowing）或底部未打通（Etch Stop）。

图 5：3D NAND 面临的多层不均匀问题及刻蚀弯曲、底部未打通问题



数据来源：Semi Engineering，金元证券研究所整理

为了解决这个问题，制造商引入了多栈（Multi-Deck）或称串堆叠（String Stacking）技术：

- 单栈（Single Deck）：在一次光刻和刻蚀步骤中贯穿所有层。三星曾长期坚持单栈工艺以减少工序成本，但在 128 层之后也达到了极限
- 多栈（Multi-Deck）：将总层数拆分为两个或多个独立的“栈”进行制造，然后像积木一样堆叠起来。例如，美光 and SK 海力士的 176 层产品，通常是由两个 88 层的结构堆叠而成。

3D NAND 微缩的核心瓶颈在于高深宽比（High Aspect Ratio, HAR）刻蚀。制造一个 3D NAND 器件，需要在氧化物和氮化物交替沉积的堆栈（ONON Stack）上，刻蚀出数以十亿计的圆柱形通道孔。

- **物理挑战：**当层数增加到 200 层以上时，通道孔的深度可达 6-10 微米，而直径仅为 100 纳米左右，深宽比高达 60:1 甚至 100:1。相当于要在地面上钻一个直径如针尖、深度达数十米的井，且必须保证井壁绝对垂直光滑。
- **深宽比依赖性刻蚀（ARDE）：**随着刻蚀深度的增加，离子和中性粒子传输到孔底变得极其困难，导致刻蚀速率下降，甚至在未到达底层时就停止（Etch Stop）。

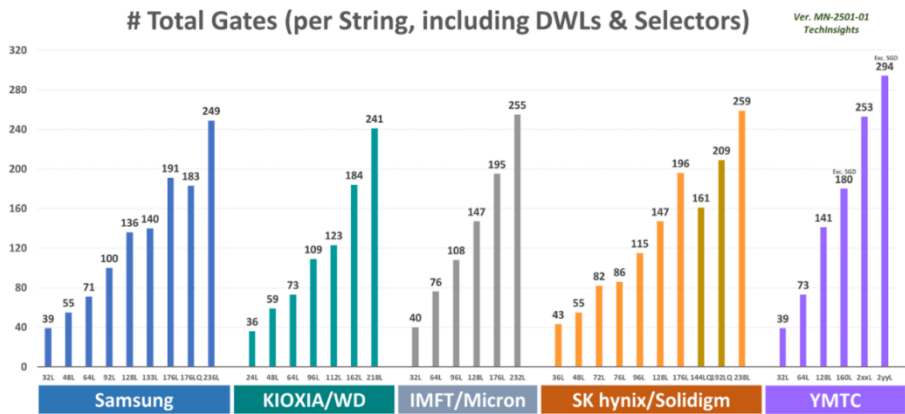
在 3D NAND 的传统架构中，如三星的 V-NAND、美光的 CTF CuA (CMOS under Array) 以及 SK 海力士的 4D PUC (Periphery Under Cell)，制造商通常在同一片晶圆上先制造外围逻辑电路（Peripheral Logic），然后上面制造存储阵列。这种单片制造（Monolithic）方法虽然成熟，但存在两个致命的妥协，一则是工艺制约，存储阵列的制造需要高温退火工艺，这会限制底部逻辑电路所能使用的晶体管类型和性能；二则是面积浪费，随着存储密度的增加，外围电路的面积并没有

同比例缩小，导致芯片面积利用率下降。

长江存储引入的 Xtacking（晶栈）架构，彻底打破了单片制造的两大困境。Xtacking 的核心理念是并行制造，异质键合。长江存储在两片独立的晶圆上分别制造存储阵列和外围逻辑电路。晶圆 A（存储阵列）专注于存储单元的垂直堆叠，不包含复杂的逻辑电路；晶圆 B（逻辑电路）使用先进的 CMOS 工艺（如 14nm 甚至更先进节点）独立制造外围控制电路，实现极高的 I/O 速度和复杂的控制逻辑。两片晶圆制造完成后，通过数百万个金属垂直互连通道（VIAs）进行面对面（Face-to-Face）的混合键合。

Xtacking 已从 1.0 演进至 4.0 版本，层数升至 294 层，接口协议至 PCIe Gen 5。Xtacking 1.0（64 层）概念验证阶段，虽然使用了两片晶圆导致成本增加，但它让长江存储在起步阶段就实现了与主流竞品相当的 I/O 速度，跳过了漫长的追赶期；Xtacking 2.0（128 层）是关键的分水岭，长江存储大胆跳过了 96 层节点，直接从 64 层跃升至 128 层。这一代产品证明了键合工艺的量产可行性，并在良率上达到了商用标准；Xtacking 3.0（232 层）引入了背面源极连接（Backside Source Connect, BSSC）技术。这项技术简化了垂直互连的工艺流程，不仅降低了成本，还进一步提升了良率。在这一代，长江存储推出了 X3-9070 产品，实现了 232 层堆叠，并在位密度上（15.47 Gb/mm² TLC / 19.8 Gb/mm² QLC）超越了同期的三星 V8 和美光 176 层产品；Xtacking 4.0（294 层 / Gen 5）面对外部制裁，根据 TechInsights 对致态 TiPro 9000 SSD 的拆解分析，这一代芯片拥有惊人的 294 层总栅极数，但实际激活的层数约为 232 层。

图 6：长江存储 3D NAND 层数领先



数据来源：Semi Engineering，金元证券研究所整理

我们认为，在易失性存储（如 DRAM）在 HBM、HMC 等领域突破后，随着 AI 推理及应用市场的持续扩张，尽管高带宽内存（HBM）解决了核心计算单元的数据吞吐问题，但在海量数据集的检索、向量数据库的索引遍历以及大模型的检查点恢复过程中，底层非易失性存储（NAND Flash）的读写性能，尤其是随机读取（IOPS）和能效比已成为制约系统整体效率的关键短板。下一步在非易失性存储（NAND、HDD）领域或将引起行业重视。从制造工艺上而言，3D 结构的 NAND 存储工艺难点在于高深宽比的刻蚀工艺、薄膜沉积及未来可能成为主流的混合键合工艺，如

长江存储在 Xtacking 2.0 阶段采用键合工艺将层数由 64 层扩展至 128 层，也验证了键合工艺的重要性。对于半导体产业链而言，AI-NAND 的发展意味着低温刻蚀、混合键合、薄膜沉积、CMP 技术的设备商或将迎来 NAND 推动的景气周期。由于工艺复杂度提升，设备在晶圆成本中的占比将持续上升。

相关公司：

- 1、设备商：中微公司（刻蚀）、拓荆科技（薄膜沉积+混合键合）、盛美上海（湿法刻蚀+清洗+电镀）、精智达（测试）等；
- 2、材料：鼎龙股份、安集科技、华特气体、南大光电等

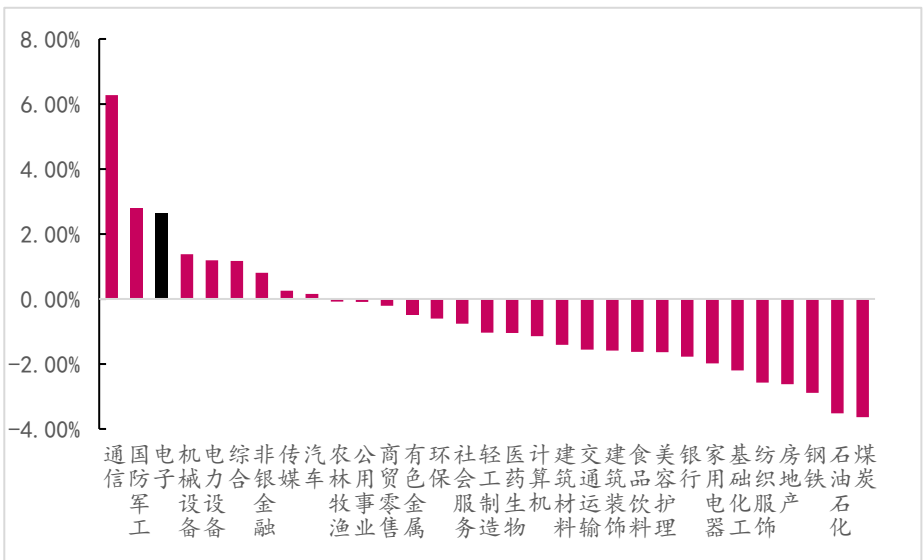
风险提示：

- 1、AI 推理不及预期：推理侧是 AI 应用及 AI 商业化的核心要素，也是存储周期的核心需求因素，若 AI 推理市场不及预期，或导致周期下行
- 2、生产端不及预期：国内设备及材料厂商仍处于追赶阶段，渗透率仍有待提升
- 3、工艺良率不及预期：3D NAND 及 HBM 封装技术仍不成熟，量产良率仍有待印证

二、行业跟踪

全行业：本周（2025.12.8-2025.12.12）上证指数下跌 0.34%，深证成指上涨 0.84%，沪深 300 指数下跌 0.08%，申万电子板块上涨 2.63%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 3/31。板块个股涨幅前五名分别为：富信科技、东田微、赛微电子、鸿日达、立昂微；跌幅前五名分别为：惠伦晶体、华映科技、*ST 宇顺、睿能科技、泓禧科技。

图 7：本周各行业板块涨跌幅



数据来源：Choice，金元证券研究所整理

表 1：本周电子板块个股涨幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
688662.SH	富信科技	45.57	59.00	40.89	63.17	56.52	49.88	26.12
301183.SZ	东田微	35.90	185.88	140.20	198.00	137.45	80.58	139.49
300456.SZ	赛微电子	29.37	62.33	47.45	66.66	116.20	694.26	395.37
301285.SZ	鸿日达	27.93	70.41	55.16	70.99	44.26	34.74	22.56
605358.SH	立昂微	26.84	37.29	29.29	38.50	37.62	252.57	87.99

数据来源：Choice，金元证券研究所整理

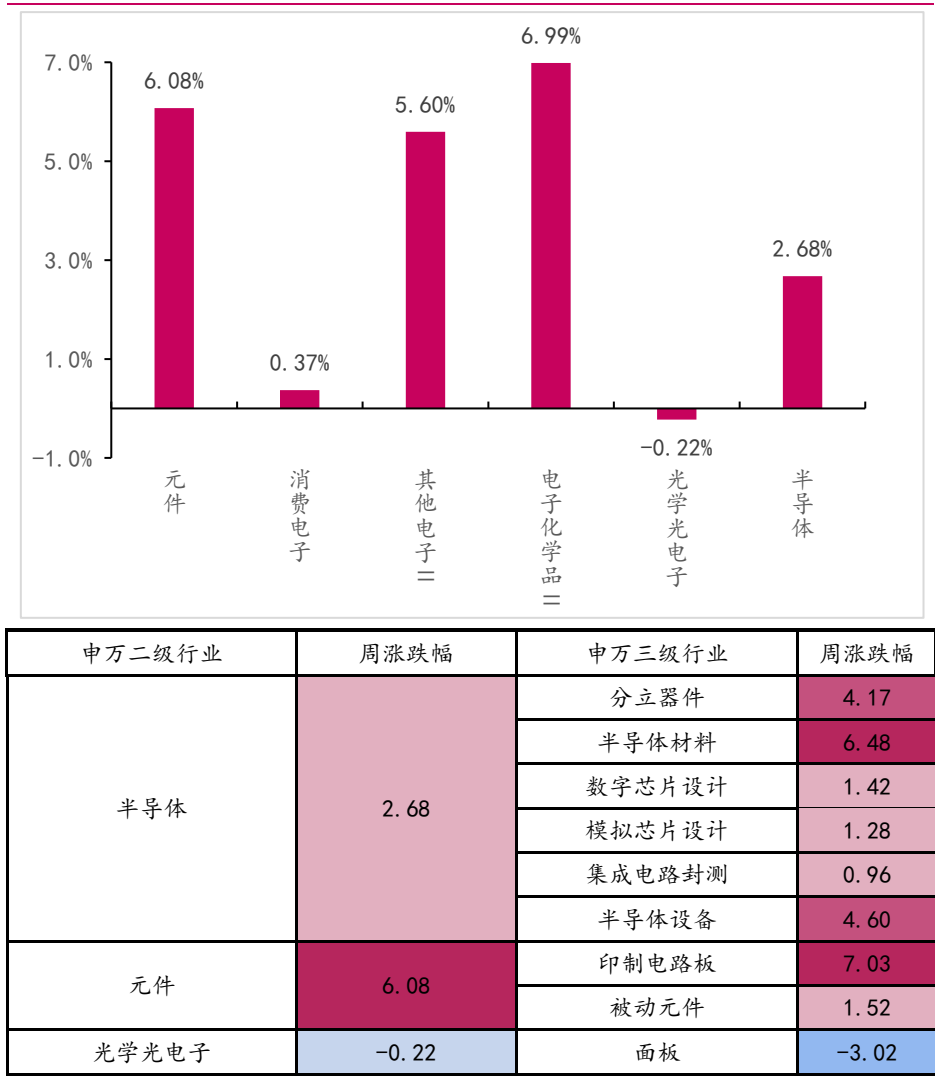
表 2：本周电子板块个股跌幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
300460.SZ	惠伦晶体	-18.53	8.44	8.20	11.66	43.27	121.49	12.07
000536.SZ	华映科技	-16.61	5.02	4.98	6.60	65.24	1802.68	105.00
002289.SZ	ST 宇顺	-15.06	29.78	29.70	35.65	5.59	15.66	5.01
603933.SH	睿能科技	-13.78	25.53	24.77	32.55	75.53	156.75	43.36
871857.BJ	泓禧科技	-12.40	28.97	28.82	33.39	6.55	4.84	1.48

数据来源：Choice，金元证券研究所整理

电子行业：本周（2025.12.8 - 2025.12.12）电子行业呈现涨跌分化格局，从申万二级行业数据看，子板块涨跌互现，部分板块内部结构差异显著。电子化学品板块本周上涨6.99%，为本周表现最强的方向；其下申万三级行业电子化学品Ⅲ同幅上涨6.99%，走势完全一致。元件板块上涨6.08%，表现同样亮眼；其下申万三级行业印制电路板上涨7.03%、被动元件上涨1.52%，细分领域涨幅分化。其他电子板块上涨5.60%；其下申万三级行业其他电子Ⅲ同幅上涨5.60%，走势同步。半导体板块本周上涨2.68%，内部结构差异较大；其下申万三级行业半导体材料上涨6.48%、半导体设备上涨4.60%、分立器件上涨4.17%，是板块核心拉动力量；数字芯片设计上涨1.42%、模拟芯片设计上涨1.28%、集成电路封测上涨0.96%，内部涨幅分化突出。消费电子板块整体上涨0.37%，延续温和态势；其下申万三级行业消费电子零部件及组装上涨0.44%，对板块形成支撑，品牌消费电子下跌0.41%。光学光电子板块本周下跌0.22%，表现相对弱势；其下申万三级行业光学元件上涨5.60%，而面板下跌3.02%、LED下跌0.48%，细分领域涨跌分化明显。总体来看，本周电子行业子板块涨跌分化显著，电子化学品、元件等领涨，半导体板块内部分化突出，光学光电子表现偏弱，行业呈现局部活跃但整体涨跌不一的态势。

图 8：本周电子版块：子版块涨跌幅



		LED	-0.48
		光学元件	5.60
消费电子	0.37	品牌消费电子	-0.41
		消费电子零部件及组装	0.44
电子化学品	6.99	电子化学品III	6.99
其他电子	5.60	其他电子III	5.60

数据来源: Choice, 金元证券研究所整理

图 9: 电子板块历史走势



数据来源: Choice, 金元证券研究所整理

图 10: 电子板块历史市盈率



数据来源: Choice, 金元证券研究所整理

三、行业新闻

记忆体超级周期挡不住，华邦电11月营收创41个月最佳表现线

12月8日据《科技新报》报道，记忆体大厂华邦电公布含新唐科技等子公司自结11月合并营收，金额达到86.3亿元，较10月份增加4.91%，较2024年同期增加38.7%，是自2022年6月以来经历41个月的新高数字。2025年前11月营收累计达796.36亿元，较2024年同期成长5.85%。华邦电总经理陈沛铭先前法说会上表示，华邦电DRAM业务创下过去三年的新高点，公司对第四季及未来长期的成长前景表示乐观，预期营收、出货量和平均销售价格都将迎来更大幅度的成长，并回归到正常的成长轨道。此外，有媒体观察到华邦电有越来越多客户愿意签长约一事，陈沛铭也曾对此指出，当前客户要求签订长期供货合约时，华邦电倾向于锁定数量，而非固定价格。

美国国际贸易委员会裁定，英飞凌提告英诺赛科专利侵权案胜诉

12月8日据《科技新报》报道，美国国际贸易委员会裁定英诺赛科侵犯了英飞凌拥有的一项氮化镓技术专利。初步判决，美国国际贸易委员会也确认了英飞凌本案诉讼主张的两项专利均具法律效力。本案核心在英诺赛科未经授权使用英飞凌的氮化镓专利技术。委员会最终裁决2026年4月2日公布。若这项初步裁决最终获得确认，将导致英诺赛科涉嫌侵权的产品禁止进口美国。此项裁决是又一次具有正面意义的结果，彰显了英飞凌对氮化镓的重要贡献。德国另一项并行诉讼，德国专利局近期确认英飞凌一项专利有效性，并以略作修正形式维持专利。英飞凌正在慕尼黑地方法院对该专利提出侵权诉讼。

Google前研究员让企业从零设计复杂晶片，或重塑8,000亿美元晶片业

12月8日据《科技新报》报道，位于加州帕罗奥图的新创Recursive Intelligence正在努力重塑价值8,000亿美元晶片业。创办者为两名Google前研究员Anna Goldie与Azalia Mirhoseini，成功募集3,500万美元风险投资，主要来自知名风险投资公司Sequoia Capital。Recursive目标是开发自动化先进晶片设计的软体，使企业从零开始设计复杂晶片。软体使用人工智慧加速晶片设计流程，大幅降低成本并缩短开发期。这对竞争激烈的半导体市场，追求技术突破和产品差异化的企业有重要战略意义。虽然公开资料较少，但Recursive专注结合软体和硬体设计自动化，提升晶片生产效率与灵活性，可能涉及使用现代机器学习算法以最佳化晶片功能和能源效率。

苹果面临数十年来最大规模离职潮，晶片主管Srouji可能是下一位离职

12月8日据《科技新报》报道，苹果长期以来是矽谷稳定的典范，却突然面临数十年来最大规模的离职潮，过去一周，苹果人工智慧与介面设计主管双双离职，随后总法律顾问及政府事务主管也离职，甚至是苹果备受推崇的内部晶片计画设计师约翰尼·斯鲁吉也说正认真考虑近期离职。Meta、OpenAI及多家新创挖角许多苹果工程师，威胁到苹果在人工智慧领域追赶的速度，如今又有苹果四位高阶主管直接向执行长库克请辞，标志着苹果高阶主管的流动率极高，成为库克任内最动荡的时期。苹果近期的变动已开始重塑内部的权

力结构，使更多权力流向四位高管，包括特纳斯、服务主管克佑、软体主管费德里吉以及新任营运长沙比汗，而苹果的人工智慧已重新分配给费德里吉。

特斯拉Optimus跑步时速可达14公里，可能比你我都快

12月8日据《科技新报》报道，特斯拉Optimus团队公开影片，展示第二代Optimus在实验室轻盈跑步，步伐稳定度超越旧版。团队指这次测试刷新实验室个人最佳纪录。Optimus跑步时有双脚同时离地过，有人分析秒速约3.8公尺，即时速约14公里，比Unitree H1等对手更快。特斯拉改良平衡、协调及步态控制，使机器人从只能走路进阶至跑步，使马斯克说Optimus不久后就能取代人类重复性工作的愿景又靠近一步。网友还将两年半前Optimus跑步影片比较，特斯拉2024年8月在香港圆方Elements商场展出Optimus原型，香港官网说Optimus目标是执行危险及重复性工作。业界预估Optimus将成为特斯拉FSD系统后第二增长动力。

SK海力士调整2026年HBM4量产时间与产能

12月9日据《科技新报》报道，SK海力士修改HBM4生产计划，原计划2026年2月量产HBM4，并第二季末扩大产量。修正后HBM4实际量产起始时间延至2026年3-4月，扩大生产时间点延至第三季。报导引用消息人士说法，SK海力士原定2026上半年逐步提升HBM4产能，第二季末提高整体HBM比重。但现决定至少2026上半年，前代HBM3E生产比重仍维持最高。消息人士透露，SK海力士与辉达讨论2026年HBM供货时，发现HBM3E采购量大幅增加，为满足当前市场对HBM3E的稳健需求，SK海力士选择优先确保HBM3E供应。SK海力士回应，虽然无法确认经营策略相关细节，但计划根据市场需求，采取灵活应对措施。

Gemini3爆发带旺TPU需求，却面临CoWoS供应不足

12月9日据《科技新报》报道，自从Google发布Gemini3，并在多数基准测试中胜过OpenAI等主要竞争者后，市场对Google自研晶片能力的评价全面改观。Gemini3完全以Google自家TPU训练，使外界重新检视TPU的性能潜力与成本效益，若Google想将TPU推向更大规模的外部市场，能否取得足够的台积电先进封装产能，仍是最关键的挑战。据报导，Google最新一代TPUv7采用先进的双晶片设计，并采用CoWoS先进封装技术，将运算核心与记忆体高密度整合于单一模组之中。然而，台积电CoWoS产线长期被辉达与苹果大量占用，使得新进客户要获得稳定配额相对困难。市场普遍推测，Google即便有能力满足自家资料中心的TPU部署，但若想向外大规模供货，封装产能的排序与分配将成为最直接的限制。

记忆体领军带动台股大盘上攻逾300点，华邦电、旺宏涨停锁死

12月9日据《科技新报》报道，受惠记忆体价格持续上涨趋势，加上美商记忆体大厂美光在宣布全面退出消费性记忆体市场，全面抢攻资料中心AI晶片的记忆体需求，使得上周最后一个交易日，美光收盘价大涨近5%的影响，8日台股记忆体类股全面走扬。8日记忆体类股除了指标性的南亚科盘中大涨近7%，股价来到163.5元的价位之外，华邦电与旺宏更是一举攻上涨停的价位，群联最高涨幅也超过7%，创见也超过6%，威刚与十铨也都有超过2%的表现，而凌航、宇瞻也都呈现上涨的格局。

台积电CoWoS先进封装全线满载，外包订单加速英伟达、苹果芯片交付

12月9日据《IT之家》报道，台积电目前面临CoWoS先进封装产能严重饱和的困境，已无法单独满足英伟达、苹果等客户对AI芯片的爆发式需求。为解决这一瓶颈，台积电决定改变策略，将部分“溢出”订单外包给日月光投控和矽品精密等封测大厂。为了承接这波需求，日月光等厂商此前已宣布投入数十亿美元扩大生产规模。这种合作模式不仅能缓解台积电当下的交付压力，也让整个供应链在面对AI芯片需求的爆发式增长时表现出更强的韧性。这一策略调整背后还隐藏着深层的竞争考量：英特尔近期在先进封装领域动作频频，试图吸引苹果和高通等客户。台积电通过外包扩充可用产能，能够有效避免客户因等待时间过长而流向竞争对手，从而巩固其在高端封装市场的统治地位。

受惠科技大厂全球建厂遍地开花，矽科宏晟预计12月底挂牌上柜

12月9日据《科技新报》报道，由日本知名化学品大厂关东化学与台湾自动监控系统宏晟合资的矽科宏晟，明日将举办上柜前业绩发表会，预计12月底挂牌交易。总经理柯灿涂表示，随着晶圆代工大厂全球设厂，还有新加坡建厂机会，明年营运有望优于今年。柯灿涂分享，矽科宏晟全球布局持续扩张，并积极在中国、日本、美国与新加坡等地设点，同步参与多国半导体新厂建置，并持续争取海内外建厂专案。柯灿涂强调，伴随全球半导体产业进入新一轮扩张周期，AI、高效能运算、先进封装与成熟制程需求齐发，化学品供应系统的建置与维运将成为各国新厂投资的关键，矽科宏晟以横跨设备、工程与维运的完整供应能力，有望在科技大厂资本支出潮中持续扩大版图。

高通宣布收购Ventana Micro Systems

12月10日据《IT之家》报道，高通12月10日晚宣布收购Ventana Micro Systems，进一步强化其在RISC-V领域的技术布局。高通表示，此次收购凸显了高通在推动RISC-V标准及相关生态发展方面的承诺，同时借助Ventana在RISC-V指令集开发上的专业能力，提升公司整体CPU工程实力。据高通介绍，Ventana团队将与公司现有的Oryon自研CPU与RISC-V研发项目形成互补，共同推动各业务领域在AI时代的技术演进。高通负责技术规划、边缘解决方案与数据中心业务的执行副总裁兼总经理Durga Malladi称，RISC-V架构具备推动CPU创新的潜力，此次收购是高通打造行业领先的RISC-VCPU技术的重要一步。Ventana Micro Systems首席执行官Balaji Baktha表示，公司团队期待与高通合作，在Oryon技术开发中贡献RISC-V专业能力，并推动面向下一代产品与应用的高性能、低功耗计算突破。

AMD发布FSR Redstone技术及25. 12. 1 WHQL驱动更新

12月10日据《IT之家》报道，AMD于12月10日正式推出了面向Radeon RX 9000系列显卡的全新图像强化技术“FSR Redstone”，标志着该公司在AI / ML游戏图像增强领域迈入新阶段。与此同时，AMD还发布了适用于Windows的最新驱动程序版本更新25. 12. 1，与之前的版本相比性能有所提升。与此前按版本迭代的方式不同，“Redstone”成为AMD整套AI画质提升、帧生成与光线重建技术的统称。此次全新亮相的FSR Redstone则被定位为更进一步的完整技术演进，官方宣称能够在保持画质的前提下提供卓越性能，并在部分场景实现

“超越原生分辨率”的画质。AMD方面同时强调，目前已有超过200款游戏采用了FSR技术，并预计未来会有更多作品加入，包括《战锤40K：暗潮》等新作即将支持Radiance Caching。

英特尔挑战欧盟反垄断决定失败，但罚款大减1.4亿欧元

12月10日据《IT之家》报道，当地时间周三，美国芯片制造商英特尔挑战欧盟反垄断决定失败，但是罚款金额减少了大约1.4亿欧元。2023年，欧盟委员会认定，英特尔滥用其芯片市场支配地位，对其罚款3.76亿欧元。这笔罚款涉及英特尔在2002年11月至2006年12月期间向惠普、宏基和联想支付费用，以阻止或推迟竞争对手产品的上市。此前，欧盟普通法院推翻了欧盟委员会2009年针对英特尔排挤AMD作出的10.6亿欧元罚款。欧盟普通法院周三支持欧盟委员会对英特尔滥用市场支配地位的认定，同时裁定将罚款金额从3.76亿欧元进一步调降。法官指出，受英特尔限制措施影响的计算机数量相对有限，且部分反竞争行为之间存在12个月的时间间隔，2.37亿欧元的罚款更能恰当反映该侵害行为的严重性及其持续时间。

特朗普批准英伟达对华出售H200，引发美国两党反对

12月10日据《电子工程专辑》报道，12月8日，美国总统特朗普在Truth Social上宣布一项备受争议的决定：允许美国芯片巨头英伟达向中国出售其高性能人工智能芯片H200，条件是美国政府获得该交易销售额的25%。这一决定遭到了包括一些共和党人在内的美国两党的反对。特朗普透露，美国商务部正在敲定相关细节，且相关作法同样适用于AMD、英特尔以及其他美国公司。对此，英伟达通过声明回应：“向经过商务部审核的获批准商业客户提供H200芯片，实现了平衡，对美国非常有利。”知情人士称，美国政府官员认为此举是在两种极端之间取得折衷，即在保证美国在AI芯片在硬件上优势的同时，又能防止华为进一步扩大在中国市场销售AI芯片。

TrendForce表示DDR4领涨内存市场，DDR5/DDR3年底小幅回调不影响未来涨势

12月10日据《IT之家》报道，TrendForce发布的最新报告显示，随着年底临近，不同类型DRAM产品呈现分化走势。DDR5与DDR3在前期大幅上涨后本周出现小幅回落，主要来自部分现货交易商的年底获利了结操作，这一调整并未改变整体供应紧张的市场格局。DDR4尤其是16Gb产品，涨势依旧强劲。TrendForce认为，这些短期变化并不会影响DRAM合约价在未来持续大幅上涨的趋势。与此同时，NAND Flash现货市场则在供应端的支撑下持续刷新历史高点，尽管涨幅较此前有所放缓。整体来看，DRAM与NAND市场都受供应紧缩影响，DDR4仍是涨势最明显的产品线，而NAND价格在供应端收紧下继续维持在高位水平。

三星正招募工程师，筹备在美国生产特斯拉AI5芯片

12月11日据《IT之家》报道，特斯拉供应商三星正筹备量产AI5芯片，此举将进一步推动该公司在自动驾驶领域的发展。据韩媒Sedaily最新报道，三星正在加快其在美国生产AI5芯片的准备工作，近期已为其客户工程团队招募了一批经验丰富的工程师。该团队将协助解决复杂的晶圆代工难题，稳定生产良率，并确保这一新项目的制造流程顺利推进。AI5芯片是特斯拉为其自动驾驶系统开发的下一代专用硬件，同时也将用于Optimus人形机器人项目，以及车

辆和其他产品中的各类人工智能驱动功能。马斯克称AI5是一项令人惊叹的设计，相较当前的AI4芯片运算速度提升约40倍，原始算力提高8倍，内存容量增加9倍，同时每瓦能效也达到AI4的3倍。马斯克确认，AI5芯片将于明年“小批量”装车；但要实现大规模量产，则需等到2027年。

SpaceX拟明年启动史上最大规模IPO，目标估值1.5万亿美元

12月11日据《电子工程专辑》报道，埃隆·马斯克旗下的太空探索技术公司正积极推进首次公开募股计划，目标在2026年中后期完成上市，SpaceX此次IPO计划筹资额将远超300亿美元，成为有史以来规模最大的首次公开募股。SpaceX管理层与顾问团队目前正在积极筹备上市事宜。一位知情人士透露，近日SpaceX敲定了最新一轮内部股票出售计划，与此同时，马斯克和公司董事会推进了上市和融资计划，包括关键岗位的招聘以及资金用途等。据悉，SpaceX计划将部分IPO募集资金用于发展太空数据中心项目，包括采购运行这些数据中心所需的专用芯片。分析人士指出，SpaceX选择在2026年推进IPO，恰逢其业务进入高速成长期，时机选择与公司发展轨迹高度契合。

韩系设备商内斗，SK海力士HBM4设备订单转向新加坡厂商

12月11日据《电子工程专辑》报道，在HBM4竞赛白热化的关键节点，韩国存储巨头SK海力士悄然将一份价值约300亿韩元的设备订单交给了新加坡半导体封装设备厂商ASMPT，用于其下一代HBM4芯片的量产。SK海力士之所以作出这一决策，是由韩国本土设备供应商韩美半导体与韩华半导体因专利纠纷陷入内耗所致。据韩国媒体TheElec近日报道，SK海力士已于2025年11月向ASMPT订购7套热压键合机，每套配备两个键合头，用于HBM4的堆叠制造。SK海力士计划于2026年3月再订购100套HBM4用TC键合机，以配合清州M15X晶圆厂的扩产。届时，ASMPT、韩美、韩华三方将展开更激烈的订单争夺。但若韩系厂商无法尽快解决专利纷争，ASMPT或将进一步扩大份额，甚至主导HBM4设备供应。

英伟达被曝开发“芯片定位”技术，H200芯片装上“安全枷锁”

12月11日据《电子工程专辑》报道，英伟达已秘密开发一种可追踪其AI芯片运行地理位置的“位置验证”技术。这一功能利用GPU的“机密计算能力”，通过测量芯片与英伟达服务器通信的延迟估算其所在国家。尽管英伟达声称这款软件最初的设计意图是协助客户追踪芯片的整体计算性能，但外界普遍认为，其真实目标是配合美国对华出口管制，防止高性能芯片被“走私”至禁售地区。这一消息恰逢美国总统特朗普高调宣布批准英伟达向中国出售 H200 AI芯片。英伟达此次推出的“芯片定位”技术是实现特朗普提出条件中“国家安全”的技术路径之一。这项新曝光的定位功能进一步加深了中国市场对其芯片存在“后门”的担忧，如果英伟达不能解决“监控”或“后门”安全问题，那么仍将很难在中国市场有所建树。

长江存储就“涉军清单”和“实体清单”在美提起诉讼

12月11日据《电子工程专辑》报道，长江存储在美国华盛顿联邦法院正式对美国国防部和商务部就其被无端列入“中国军事企业清单”及“实体清单”提出诉讼。长江存储要求法官阻止国防部将其列入所谓的“涉军名单”，并撤销这一不当认定。长江存储指出，美国国防部所依据的信息既过时又不准确，对公

司造成了“重大且持续的财务和声誉损害”，导致公司失去了与美国合作伙伴的业务。公司明确指出，其产品全部用于笔记本电脑、智能手机等消费电子领域，属商用级规格，从未涉及任何军事用途。与此同时，长江存储还就2022年被美国商务部列入“实体清单”一事提起诉讼。公司强调，其拥有健全的出口合规体系，且美方从未指控其违反任何出口管制法规。

美国推出“Pax Silica”计划，欲构建可信、安全AI技术联盟

12月12日据《电子工程专辑》报道，美国将主导推动一项名为“Pax Silica”的战略计划。该计划旨在构建一个安全、繁荣、创新驱动的硅供应链，从关键矿物和能源投入到先进制造、半导体、人工智能基础设施和物流。这一计划寓意通过协作而非对抗，确保支撑AI发展的基础材料、技术和基础设施掌握在“可信赖”的国家手中。美国正在组织一个国家联盟，其宗旨是构建一个安全、有韧性、以创新为驱动的全球技术供应链生态系统。首届Pax Silica峰会已汇聚日本、韩国、新加坡、荷兰、英国、以色列、阿联酋和澳大利亚等国代表，这些国家不仅是全球半导体、先进制造和AI研发的重要枢纽，更拥有英伟达、ASML、三星等关键企业及大量技术投资者，构成了当今AI供应链的骨干力量。

蓝思科技收购PMG，抢滩AI硬件千亿市场

12月12日据《电子工程专辑》报道，蓝思科技发布公告，拟以战略方式收购萨摩亚注册公司PMG International Co., Ltd. 100%股权，从而间接控股元拾科技（浙江）有限公司95.11645%的股份。此举被市场广泛解读为蓝思科技加速布局AI算力硬件赛道的关键一步，更意味着其有望正式切入全球AI芯片巨头英伟达的供应链体系。目前，元拾科技已进入英伟达供应链，并与其少数股东品达科技股份有限公司形成“散热模组+算力机柜”的垂直整合能力。而品达科技本身也已出现在英伟达2025年公布的散热组件合作厂商名单中。此次收购的核心价值在于，蓝思科技将通过元拾科技间接获得英伟达RVL认证——这是英伟达对其液冷与散热领域供应商进行综合能力评估后授予的关键资质，堪称进入AI服务器核心供应链的“通行证”。

英伟达否认“DeepSeek使用禁售Blackwell芯片”相关传闻

12月12日据《IT之家》报道，英伟达否认了中国AI初创公司深度求索使用禁售的Blackwell芯片训练最新模型相关指控。英伟达在致科技媒体Mobile World Live的邮件声明中回顾了过往传闻，其中外媒《The Information》前天援引六位匿名消息人士称，DeepSeek所使用的Blackwell芯片通过复杂走私手段被运往中国。《The Information》在报道中提到，装有Blackwell的服务器首先被运送到允许出口国家的数据中心，经过检查后拆掉芯片并出口至中国，但并未指出走私芯片的具体国家/地区。英伟达发言人对此回应从未发现所谓“规避监管的欺骗公司或OEM合作伙伴建造幽灵数据中心，随后拆解、走私并异地重建”的实质性证据或线索。随后发言人在声明中补充尽管走私听起来有些牵强，但会继续追查收到的所有线索。

GPT-5.2模型发布，做表格/PPT、处理超长上下文是专长

12月12日据《IT之家》报道，OpenAI正式发布前沿模型GPT-5.2。官方将这款

模型定位为迄今最先进的模型，专为开发者和专业用户而打造。GPT-5.2将通过API提供给ChatGPT付费用户和开发者，分为Instant、Thinking和Pro三类。其中，Instant强调速度，适用于信息查询、写作和翻译；Thinking负责处理编码、长文档分析、数学与规划等结构化难题；Pro面向最高难度场景，强调最稳健、最可靠的输出。OpenAI首席产品官Fidji Simo说，“OpenAI打造5.2的目的在于解锁更多的经济价值，GPT-5.2在制作表格、生成简报、写代码、理解图像、处理超长上下文以及执行多步骤工具链任务时表现更强。”GPT-5.2在编码、数学、科学、视觉、长文本推理和工具使用上的表现全面提升，可支撑更可靠的智能体工作流、更稳定的企业级代码和能处理大规模真实数据的复杂系统。

台积电日本熊本二厂停工

12月12日据《电子工程专辑》报道，台积电被曝正考虑调整其日本熊本县第二晶圆厂的制程规划，从原计划的6nm/7nm升级至更先进的4nm技术，以应对人工智能芯片需求的爆发式增长。该工厂已于12月初暂停施工，重型设备撤离现场，供应商亦接到停工通知。台积电熊本二厂原计划于2027年底投产，主要生产6nm/7nm及40nm制程芯片，目标市场涵盖自动驾驶、AI等领域。知情人士透露，台积电此次调整旨在匹配市场对AI尖端半导体的迫切需求——4nm制程因性能更优、能效更高，已成为AI芯片的主流选择。据行业专家分析，4nm制程虽与6nm/7nm在设备复用率上可达90%，但需增加极紫外光刻机等关键设备，且生产线需重新设计。此次调整可能导致量产时间推迟，但若成功落地，将成为日本首个具备4nm制程的晶圆厂，显著提升日本在AI半导体领域的自主供应能力。

四、公司公告

经纬辉开：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告

公司于12月8日发布公告，天津经纬辉开光电股份有限公司披露公司董事、高级管理人员陈建波先生拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份。截至公告披露日，陈建波先生持有本公司股份61,302,902股，占公司总股本10.67%。根据公告，陈建波先生计划自公司披露股份减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，即2025年12月31日至2026年3月30日，减持本公司股份不超过14,359,000股，占公司总股本2.50%。公司表示，本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生不利影响，后续公司将及时履行信息披露义务。

中富电路：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划的预披露公告

公司于12月8日发布公告，深圳中富电路股份有限公司披露公司控股股东、实际控制人之一致行动人中富电子有限公司、深圳市睿山科技有限公司、深圳市泓锋实业发展有限公司拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份。截至公告披露日，中富电子持有公司54,500,000股，占本公司总股本28.47%；睿山科技持有公司29,539,200股，占本公司总股本15.43%；泓锋实业持有公司

18,493,800股，占本公司总股本9.66%。根据公告，上述股东计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,914,300股，占公司总股本1%；通过大宗交易方式减持公司股份不超过3,828,602股，占公司总股本2%，合计减持公司股份不超过5,742,902股，占公司总股本3%。公司表示，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

捷邦科技：关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%股权的进展公告

公司于12月8日发布公告，捷邦精密科技股份有限公司披露公司收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%股权进展。公司此前发布公告，将以人民币40,800.00万元收购王友春、王志超、张亮旗、深圳市赛诺投资合伙企业（有限合伙）、王辉、张家港深投控赛格合创股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市创新投资发展合伙企业（有限合伙）、苏州安盈同泽创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市美格智投创业投资有限公司、东莞粤海银瓶发展有限公司、新余暄昊常胜壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州安洁资本投资有限公司、海口市国盈君和企业管理合伙企业（有限合伙）等13名股东合计持有的赛诺高德51%股权。2025年3月，公司受让了赛诺高德12名股东合计所持有的赛诺高德49.90%的股权。根据此次公告，赛诺高德完成了剩余1.10%股权转让事项的工商变更登记手续，本次变更完成后，公司持有赛诺高德51.00%的股权，对应的注册资本为1,852.0341万元。

乾照光电：关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

公司于12月9日发布公告，厦门乾照光电股份有限公司披露拟与控股股东关联方海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》。根据公告，海信财务公司提供的主要金融服务内容为存款每日日终余额不超过人民币7亿元（含利息）；贷款、财务公司承兑汇票等信贷业务每日日终余额不超过人民币6亿元（含利息及手续费）；票据贴现服务，贴现利息每年上限不超过人民币200万元；资金收支结算等代理类服务，服务费每年上限不超过人民币2万元。本次交易事项经2025年12月8日董事会和监事会审议通过，尚需获得股东大会批准。公司表示，本次交易不影响公司日常资金的使用，不会损害公司以及公司中除关联股东以外的其他股东利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，不会对公司的经营成果造成重大不利影响。

瑞芯微：利润分配预案公告

公司于12月9日发布公告，瑞芯微电子股份有限公司披露2025年前三季度利润分配预案。根据公告，本次利润分配以本次利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利总额为126,278,895元，资本公积不转增。本次现金分红总额预计占公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的16.20%。本次利润分配预案经2025年12月8日董事会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

芯联集成：关于拟对外出售资产暨关联交易的进展公告

公司于12月9日发布公告，芯联集成电路制造股份有限公司披露公司控股子公

司芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司与临港新片区基金设立合资公司上海芯港联测半导体有限责任公司完成工商注册登记手续，并取得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局核发的《营业执照》。截止本公告披露日，交易各方已签署相关交易协议。根据协议约定，公司及公司子公司将持有的检测业务设备转让芯港联测及将相关的专利及非专利型专有技术授权许可给芯港联测，价格为47,176.00万元（不含增值税），增值28,815.98万元。后续交易双方将继续按照合同约定，完成交易标的的所有权转让、授权许可、款项支付等相关手续。

科森科技：关于出售全资子公司股权的公告

公司于12月9日发布公告，昆山科森科技股份有限公司披露拟向江苏耀岭科医疗科技有限公司出售全资子公司江苏科森医疗器械有限公司100%的股权。根据公告，本次交易金额为人民币9.15亿元，增值率206.45%，本次交易完成后，公司将不再持有科森医疗股权，科森医疗不再纳入公司的合并报表范围。本次交易经2025年12月8日董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司表示，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，后续公司将持续推进本次全资子公司股权出售相关进程，并依照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

赛微微电：关于股东减持股份计划的公告

公司于12月10日发布公告，广东赛微微电子股份有限公司披露上海岭观企业管理合伙企业（有限合伙）拟以集中竞价方式减持公司股份。截至公告披露日，上海岭观直接持有公司33,489股，占公司总股本0.03888%。此外，上海岭观及其一致行动人上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）、北京武岳峰中清正合科技创业投资管理有限公司作为有限合伙人在公司控股股东东莞市伟途投资管理合伙企业（有限合伙）中的合计出资比例为51.61%，东莞伟途现直接持有公司股份17,610,600股，占公司总股本20.44%。根据公告，上海岭观计划于本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内，减持其直接持有的不超过14,500股股份，约占公司总股本的0.016833%。公司表示，本次减持不会对公司控制权、治理结构及持续经营情况产生重大影响。

乾照光电：关于董事长减持股份预披露公告

公司于12月10日发布公告，厦门乾照光电股份有限公司披露董事长李敏华先生拟以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份。截至公告披露日，李敏华先生持有公司股份580,000股，占公司总股本的0.06%。根据公告，李敏华先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，合计减持公司股份不超过145,000股，占公司总股本的0.02%。公司表示，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，后续公司将及时履行信息披露义务。

奕东电子：2025年前三季度权益分派实施公告

公司于12月10日发布公告，奕东电子科技股份有限公司披露2025年前三季度权益分派方案。根据公告，本次权益分派以公司现有总股本剔除已回购股份3,038,900.00股后的231,601,100.00股为基数，向全体股东按每10股派发现

金股利人民币1.000000元（含税），实际派发现金分红总额为23,160,110.00元（含税），本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。公司回购专用证券账户中已回购股份3,038,900股不享有利润分配权利，不参与本次利润分配。本次权益分派股权登记日为2025年12月16日，除权除息日为2025年12月17日。A股股东现金红利由中国结算深圳分公司代派，股东邓玉泉、东莞市奕东控股有限公司的现金红利由公司自派。本次权益分派方案已经2025年11月12日股东会审议通过。

兴福电子：关于购买资产暨关联交易的公告

公司于12月10日发布公告，湖北兴福电子材料股份有限公司披露公司拟以自有资金购买关联方湖北三峡实验室的光刻胶用光引发剂制备专有技术及实验设备所有权。根据公告，以2025年10月31日为评估基准日，拟购买的标的资产评估价值为4,626.78万元（含税）。经交易双方协商一致同意，标的资产转让交易价格拟定为4,626.78万元（含税），本次交易构成关联交易，相关事项经2025年12月9日董事会审议通过，尚须提交公司股东会审议。公司表示，本次交易不会影响公司的正常生产经营，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

富乐德：关于出售参股公司部分股权的公告

公司于12月10日发布公告，安徽富乐德科技发展股份有限公司披露公司拟转让参股公司无锡海古德新技术有限公司410.07万股，转让价格合计69,998,949元。根据公告，本次转让前富乐华持有海古德1,298.561万股，占其总股本比例为12.87%，转让后富乐华持有海古德888.491万股，占其总股本比例为8.80%，本次股权转让不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，相关议案已经2025年12月09日董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司表示，本次交易遵循客观、公平、公允的定价原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

思瑞浦：关于终止筹划重大资产重组事项的复牌公告

公司于12月10日发布公告，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司披露公司股票自2025年12月10日开市起复牌，公司定向可转换公司债券自2025年12月10日开市起恢复转股。根据公告，公司因筹划以发行股份及/或支付现金的方式购买宁波奥拉半导体股份有限公司股权并募集配套资金事项，公司股票自2025年11月26日开市起开始停牌，公司定向可转换公司债券自2025年11月26日开市起停止转股，经审慎研究，公司认为目前实施重大资产重组的条件尚未完全成熟，决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司表示，本次终止筹划重大资产重组事项不会对公司业务开展、生产经营活动和财务状况造成不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

徠木股份：徠木股份股东及董监高减持股份计划公告

公司于12月11日发布公告，上海徠木电子股份有限公司披露公司董事、高级管理人员方培喜先生计划以集中竞价方式减持公司股份。截至本公告披露日，方培喜先生持有公司股份5,809,748股，约占公司总股本的1.36%。根据公告，方培喜先生拟自本公告披露日起15个交易日后的3个月内，即2026年1月5日至

2026年4月4日，减持股份数量不超过1,452,437股，占公司股份总数的0.34%，占其所持有公司股份总数25.00%。公司表示，本次减持不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致上市公司控制权发生变更。

冠捷科技：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

公司于12月11日发布公告，冠捷电子科技有限公司披露公司拟使用公积金弥补母公司累计亏损。根据公告，截至2024年12月31日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-7,661,858,585.10元，盈余公积为99,143,044.95元，资本公积为4,253,491,405.15元，其中股本溢价4,240,429,372.71元、其他资本公积13,062,032.44元。本次公积金弥补亏损方案经2025年10月28日董事会和2025年12月10日股东大会审议通过，公司计划使用母公司盈余公积99,143,044.95元和资本公积4,240,429,372.71元，两项合计4,339,572,417.66元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损方案实施完成后，公司母公司报表口径盈余公积减少至0.00元，资本公积减少至13,062,032.44元，未分配利润补亏至-3,322,286,167.44元。债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

新相微：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

公司于12月11日发布公告，上海新相微电子股份有限公司披露公司2025年限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公告，本次限制性股票授予日为2025年12月10日，公司将以22.10元/股的授予价格向符合授予条件的44名激励对象授予限制性股票400.00万股，约占授予时公司股本总额45,952.9412万股的0.87%，股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票或公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。公司表示，本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合相关规定，后续公司将继续履行相应信息披露义务。

中巨芯：关于与关联方续签日常生产经营合同书的公告

公司于12月11日发布公告，中巨芯科技股份有限公司披露拟与公司第一大股东浙江巨化股份有限公司及其控股股东巨化集团有限公司续签《巨化集团有限公司、浙江巨化股份有限公司与中巨芯科技股份有限公司日常生产经营合同书》。根据公告，本合同书有效期限为三年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止，主要目的为规范公司与巨化股份、巨化集团在部分原材料供应、生产能源供应、公共工程维护服务、运输服务、环保检测后勤服务等方面的日常关联交易行为。公司表示，本次合同签署不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，亦不会对关联方形成较大依赖。

国科微：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告

公司于12月11日发布公告，湖南国科微电子股份有限公司披露公司董事兼高级管理人员周士兵先生、徐泽兵先生，高级管理人员龚静女士、黄然先生拟以集中竞价交易方式减持公司股份。根据公告，周士兵先生截至公告披露日持有公司股份170,818股，占公司总股本的0.0787%，计划减持公司股份不超过

42,705股，占公司总股本的0.0197%；徐泽兵先生、龚静女士分别持有公司股份202,384股，占公司总股本的0.0932%，计划减持公司股份分别不超过50,596股，占公司总股本的0.0233%；黄然先生持有公司股份175,184股，占公司总股本的0.0807%，计划减持公司股份分别不超过43,796股，占公司总股本的0.0202%。本次减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2026年1月6日至2026年4月5日。公司表示，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

光智科技：关于向激励对象授予限制性股票的公告

公司于12月11日发布公告，光智科技股份有限公司披露2025年第二期限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公告，本激励计划授予日为2025年12月10日，公司拟向429名激励对象授予不超过835.00万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的6.07%，授予价格为21.02元/股，股票来源均为公司自二级市场回购和/或定向增发的A股普通股。本次激励计划经2025年12月10日董事会审议通过。公司表示，本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合相关规定，后续公司将继续履行相应信息披露义务。

泰凌微：关于向2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的公告

公司于12月12日发布公告，泰凌微电子（上海）股份有限公司披露2024年限制性股票与股票增值权激励计划预留授予条件已成就。根据公告，限制性股票第二次预留授予日为2025年12月11日，公司拟以13.72元/股的授予价格向符合条件的19名激励对象授予55.23万股限制性股票，约占当前公司股本总额24,074.35亿股的0.23%，股票来源为公司回购的公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票。本激励计划经2025年12月11日董事会审议通过。公司表示，本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合相关规定，后续公司将继续履行相应信息披露义务。

五、下周重要事件提示

表 3：下周重要会议

行业会议				
序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办单位
1	2025 中国汽车软件大会	12.15-12.16	上海市	中国汽车工业协会等
2	2025 第七届电气工程与控制技术国际会议	12.18-12.21	重庆市	重庆大学
3	2025 第五届电子器件与应用国际会议	12.19-12.21	深圳市	IEEE、南方科技大学
公司会议				
序号	公司名称	会议名称	会议时间	
1	奥士康	股东大会举办	2025-12-19	

2	盛景微	股东大会举办	2025-12-19
3	灿瑞科技	股东大会举办	2025-12-19
4	美迪凯	股东大会举办	2025-12-19
5	东微半导	股东大会举办	2025-12-19
6	中科飞测	股东大会举办	2025-12-19
7	西安奕材	股东大会举办	2025-12-19
8	伊戈尔	股东大会举办	2025-12-18
9	GQY 视讯	股东大会举办	2025-12-18
10	阿石创	股东大会举办	2025-12-18
11	有研新材	股东大会举办	2025-12-18
12	福蓉科技	股东大会举办	2025-12-18
13	传音控股	股东大会举办	2025-12-18
14	灿芯股份	股东大会举办	2025-12-18
15	电连技术	股东大会举办	2025-12-17
16	金海通	股东大会举办	2025-12-17
17	福光股份	股东大会举办	2025-12-17
18	佰维存储	股东大会举办	2025-12-17
19	亿道信息	股东大会举办	2025-12-16
20	歌尔股份	股东大会举办	2025-12-16
21	芯瑞达	股东大会举办	2025-12-16
22	麦捷科技	股东大会举办	2025-12-16
23	奕东电子	股东大会举办	2025-12-16
24	奥瑞德	股东大会举办	2025-12-16
25	冠石科技	股东大会举办	2025-12-16
26	必易微	股东大会举办	2025-12-16
27	富创精密	股东大会举办	2025-12-16
28	广合科技	股东大会举办	2025-12-15
29	通富微电	股东大会举办	2025-12-15
30	*ST 宇顺	股东大会举办	2025-12-15
31	西陇科学	股东大会举办	2025-12-15
32	捷荣技术	股东大会举办	2025-12-15
33	上海贝岭	股东大会举办	2025-12-15
34	安路科技	股东大会举办	2025-12-15
35	寒武纪	股东大会举办	2025-12-15
36	创耀科技	股东大会举办	2025-12-15
37	艾森股份	股东大会举办	2025-12-15
38	屹唐股份	股东大会举办	2025-12-15

数据来源: Choice, 金元证券研究所整理

表 4：电子行业限售股解禁情况汇总（单位：万股）

股票代码	公司名称	解禁日期	解禁数量	总股本	解禁前		解禁后		限售股份类型
					流通 A 股	占比 (%)	流通 A 股	占比 (%)	
001389.SZ	广合科技	2025-12-15	91.58	42,568.75	15,024.22	35.29	15,115.80	35.51	股权激励限售股份
688172.SH	燕东微	2025-12-16	19,327.92	142,761.81	58,525.18	40.99	77,853.10	54.53	首发原股东限售股份
688721.SH	龙图光罩	2025-12-16	1,451.89	13,350.00	3,896.57	29.19	5,348.45	40.06	首发原股东限售股份
920128.BJ	胜业电气	2025-12-18	1,627.50	8,119.00	2,196.00	27.05	3,823.50	47.09	公开发行原股东限售股份, 公开发行战略配售股份

数据来源：Choice，金元证券研究所整理

金元证券行业投资评级标准：

增持：行业股票指数在未来 6 个月内超越大盘；

中性：行业股票指数在未来 6 个月内基本与大盘持平；

减持：行业股票指数在未来 6 个月内明显弱于大盘。

金元证券股票投资评级标准：

买入：股票价格在未来 6 个月内超越大盘 15%以上；
增持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为 5%~15%；
中性：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~+5%；
减持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~-15%；。

免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。